

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ



ПАТЕНТ

НА ВЫНАХОДСТВА

№ 13505

Способ получения тонкой пленки феррита стронция SrFeO<sub>3-δ</sub>

выдадзены

Нацыянальным цэнтрам інтэлектуальнай уласнасці  
ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь  
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэлі, прамысловыя ўзоры»

Патэнтаўладальнік (патэнтаўладальнікі):

Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению" (BY)

Аўтар (аўтары):

Гурский Леонид Ильич; Голосов Дмитрий Анатольевич; Каланда Николай Александрович (BY)

Заяўка № а 20081029

Дата падачы: 2008.08.01

Зарэгістравана ў Дзяржаўным рэестры  
вынаходстваў:

2010.05.07

Дата пачатку дзеяння:

2008.08.01

Генеральны дырэктар

Л.І. Варанецкі

**ОПИСАНИЕ  
ИЗОБРЕТЕНИЯ  
К ПАТЕНТУ**  
(12)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ (19) BY (11) 13505



(13) C1

(46) 2010.08.30

(51) МПК (2009)  
H 01F 41/14

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ

(54)

**СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ  
ФЕРРИТА СТРОНЦИЯ  $SrFeO_{3-\delta}$**

(21) Номер заявки: а 20081029

(22) 2008.08.01

(43) 2010.04.30

(71) Заявитель: Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларусь по материаловедению" (BY)

(72) Авторы: Гурский Леонид Ильич; Голосов Дмитрий Анатольевич; Каланда Николай Александрович (BY)

(73) Патентообладатель: Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларусь по материаловедению" (BY)

(56) HIROYUKI YAMADA et al. Applied Physics Letters.- 2002.- V. 80.- No. 4.- P. 622-624.

BY 2324 C1, 1998.

SU 839405 A1, 1991.

JP 5263240 A, 1993.

JP 9194293 A, 1997.

CN 2734774 Y, 2005.

КАЛАНДА Н.А. и др. Доклады БГУ-ИР.- 2006.- № 2(14).- С. 118-126.

Двухлучевой источник ионов для двойного ионно-лучевого распыления, 2007.01.05. Найдено на: [http://www-icm.by/\\_private/developments/p273/index.html](http://www-icm.by/_private/developments/p273/index.html)

(57)

Способ получения тонкой пленки феррита стронция  $SrFeO_{3-\delta}$ , включающий изготовление мишени состава  $SrFeO_{3-\delta}$ , распыление материала мишени и напыление пленки  $SrFeO_{3-\delta}$  на подложку, отличающийся тем, что используют двухлучевой ионный источник, формирующий два независимых ионных пучка, одним из которых осуществляют предварительную ионную очистку подложки и мишени и ионное ассистирование, а вторым - реактивное ионно-лучевое распыление материала мишени, напыление пленки  $SrFeO_{3-\delta}$  на подложку осуществляют в окислительной среде ионами кислорода с одновременной бомбардировкой ионами  $O_2^+$  напыляемой пленки  $SrFeO_{3-\delta}$ .

13505 C1 2010.08.30

Изобретение относится к твердотельной микро- и наноэлектронике и может быть использовано для различного вида сенсоров, кислородных мембран, электродных материалов для высокотемпературных топливных элементов, катализаторов дожига выхлопных газов, а также в энергоустановках на основе возобновляемых видов энергии.

Известен способ получения тонких пленок феррита стронция ( $SrFeO_{3-\delta}$ ) на кварцевой подложке методом лазерного напыления в инертной среде. В установке по напылению пленок  $SrFeO_{3-\delta}$  использовался лазер Nd:YAG, работающий на третьей гармонике с длиной волны 355 нм, длительностью импульса порядка 5-7 нс и частотой повторения 10Гц. Лазерный пучок диаметром в 2 мм фокусировался на поверхности мишени  $SrFeO_{3-\delta}$  под углом 45°, которая находилась на врачающемся держателе в вакууме при  $5,5 \cdot 10^{-4}$  Па с

# ВУ 13505 С1 2010.08.30

различным остаточным давлением аргона. Пленка напылялась на кварцевую подложку, располагающуюся перпендикулярно мишени на расстоянии 16 мм. Для структурирования пленки и перевода части железа из  $\text{Fe}^{3+}$  в  $\text{Fe}^{4+}$  она дополнительно подвергалась отжигу при 670-770 К на воздухе в течение двух часов с последующим охлаждением до комнатной температуры [1].

Недостатками данного способа являются: зависимость процессов кристаллизации пленки от давления Ar, при котором осуществляется напыление пленки  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$ , что затрудняет контроль над структурным совершенством пленок и соответственно воспроизводимостью их физико-химических свойств, трудность технического исполнения ввиду сложности оптимизации параметров лазерного пучка (подбор количества импульсов, их мощности, а также распределение энергии по пучку), дополнительные отжиги пленок при 670-770 К на воздухе из-за их квазиаморфности.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ получения тонких пленок феррита стронция с высоковалентным состоянием части катионов  $\text{Fe}^{4+}$ . Напыление пленок производилось с помощью лазерной установки из мишени  $\text{SrFeO}_{2,8}$ , полученной обычным твердофазным синтезом [2]. В этом случае пленки  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$  напылялись на монокристаллические подложки  $\text{SrTiO}_3$  (STO) с параметром кристаллической решетки  $a = 3,905\text{\AA}$  и ориентацией (001) ввиду того, что наиболее близким по параметрам кристаллической решетки пленки является STO подложка. Это обусловлено тем, что состав нанесенных пленок не является строго стехиометричным -  $\text{SrFeO}_3$ , а в условиях восстановительной среды имеет значения кислородного индекса  $\text{SrFeO}_{2,5}$  и в этом случае объем элементарной ячейки  $\text{SrFeO}_{2,5}$  на 7 % больше, чем  $\text{SrFeO}_3$ . Поэтому для состава  $\text{SrFeO}_{2,5}$ , подложка STO более предпочтительна. Тем не менее на основании экспериментальных данных установлено, что для улучшения структурного совершенства, магнитных, магниторезистивных и других физико-химических характеристик пленок  $\text{SrFeO}_{2,5}$  необходимо использовать дополнительные отжиги в газовой среде при температурах 1000-1100 К с 10 % содержанием озона. При этих температурах образуется высокотемпературная кубическая фаза, которая по своим параметрам ближе к подложке  $(\text{LaAlO}_3)_{0,3}(\text{SrAl}_{0,5}\text{Ta}_{0,5}\text{O}_3)_{0,7}$ .

Недостатками указанного способа являются:

Сложность технического исполнения при оптимизации параметров лазерного пучка и высокие экономические затраты, обусловленные необходимостью проведения дополнительных отжигов. Трудность контроля за структурообразованием пленок и соответственно воспроизводимостью их физико-химических свойств, из-за большой абсорбционной способности пленок на их поверхности присутствуют различные примеси и образуется неоднородность распределения кислорода по их толщине, а также зависимость процессов кристаллизации пленки от парциального давления инертных газов, при которых осуществляется напыление пленки.

Задачей настоящего изобретения является: упрощение и удешевление способа получения тонких пленок феррита стронция, обеспечение возможности проведения синтеза в условиях контроля процесса получения пленок  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$ , улучшения их магнитных, магниторезистивных характеристик, уменьшение экономических затрат (отсутствие дополнительного отжига) и воспроизводимости физико-химических свойств пленок стронциевого граната.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе получения тонкой пленки феррита стронция  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$ , включающем изготовление мишени состава  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$ , распыление материала мишени и напыление пленки  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$  на подложку.

Новым по мнению авторов является то, что для напыления пленок используют двухлучевой ионный источник, формирующий два независимых ионных пучка, одним из которых осуществляют предварительную ионную очистку подложки и мишени и ионное ассистирование, а вторым - реактивное ионно-лучевое распыление материала мишени, на-

# BY 13505 С1 2010.08.30

пыление пленки  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$  на подложку осуществляют в окислительной среде ионами кислорода с одновременной бомбардировкой ионами  $\text{O}_2^+$  напыляемой пленки  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$ .

Сущность изобретения заключается в упрощении и удешевлении способа получения тонких пленок феррита стронция, обеспечении возможности проведения синтеза в условиях контроля процесса получения пленок  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$ , улучшении их магнитных, магниторезистивных характеристик, уменьшении экономических затрат (отсутствие дополнительного отжига) и воспроизводимости физико-химических свойств пленок стронциевого граната.

Пример выполнения способа получения структурно совершенных пленок стронциевого феррита.

Для приготовления мишеней состава  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$  использовались реагенты  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SrCO}_3$  марки ОСЧ. Перемешивание и помол смеси исходных реагентов проводилось со спиртом в вибромельнице в течение 3 ч. Полученную смесь сушили при температуре 320 К до полного удаления спирта и прессовали под давлением 1-2 Т/см<sup>2</sup> в таблетки диаметром 8 мм и высотой 4 мм. Предварительный обжиг осуществлялся на воздухе при температуре 870 К в течение 18 ч. Кроме этого, нами использовался обжиг полифазной шихты состава  $\text{SrFeO}_{3-\delta} + \text{FeO}_3 + 2\text{SrCO}_3$  в атмосфере аргона при 1070 К в течение 40 ч. Это обусловлено тем, что одним из факторов, сильно ускоряющих процессы спекания и гомогенизирования, является дефектность структуры. Так, для увеличения степени химической активности реагентов в шихте увеличивали их дефектность за счет создания анионных вакансий. Для повышения гомогенизации шихты использовался вторичный сухой помол в вибромельнице в течение 2 ч. Затем из порошка прессовали мишени диаметром 85 мм и толщиной 10 мм с использованием пластификаторов и олеатов. Окончательный синтез мишени осуществляли при 1570 К в потоке кислорода в течение 3 ч с последующим охлаждением до комнатной температуры в режиме выключенной печи.

Для формирования пленок  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$  использовался метод реактивного ионно-лучевого распыления. Технология напыления реализована с использованием двухлучевого ионного источника на основе ускорителя с анодным слоем. Данный источник имеет две отдельные ступени генерации ионных пучков и формирует два независимых ионных пучка, один из которых служит для распыления материала мишени (распыляющая ступень), а второй для предварительной ионной очистки подложек и ионного ассистирования (ассистирующая ступень).

В качестве подложек использовался поликор, который располагался на подложкодержателе на расстоянии 18 см от мишени при температурах 770-950 К. Перед напылением производилась очистка подложек ионным пучком, генерируемым ассистирующей ступенью ионного источника. Для этого камера вакуумной установки откачивалась до остаточного давления  $10^{-3}$  Па. Время очистки, энергия ионов и ток разряда во всех экспериментах были постоянными и составляли соответственно 3 мин, 700 эВ, 40 мА. Тренировка мишени с целью устранения с поверхности мишени адсорбентов инородной природы осуществлялась в течение 20 мин. Особенностью представленной технологии является то, что мишень обладает достаточной электропроводностью, что позволило отказаться от использования накального нейтрализатора ионного пучка и практически исключить снижение скорости нанесения пленки при распылении мишени реактивным газом ( $\text{O}_2$ ). Распыленный материал осаждался на подложки с одновременной бомбардировкой ионами ассистирующей ступени ионного источника. Использование одновременной ионной бомбардировки растущей пленки ионами  $\text{O}_2^+$  позволяет активно управлять структурным качеством, подвижностью кислорода, электротранспортными и другими физико-химическими свойствами тонких пленок  $\text{SrFeO}_{3-\delta}$ .

Преимуществом заявляемого изобретения по сравнению с известными, является упрощение и удешевление способа получения тонких пленок феррита стронция, обеспечение возможности проведения синтеза в условиях контроля процесса получения пленок

# BY 13505 C1 2010.08.30

SrFeO<sub>3- $\delta$</sub> , увеличение их структурного совершенства, уменьшение экономических затрат (отсутствие дополнительного отжига) и воспроизводимости физико-химических свойств пленок стронциевого граната.

Источники информации:

1. Zhongke Wang<sup>a</sup>, Takeshi Sasakia<sup>a</sup>, Naoto Koshizakia\*, James J. Tunneyb, Michael L. Postb Crystallized SrFeO films deposited by pulsed 3yx laser ablation without in-situ substrate heating // Thin Solid Films. - 437 (2003).- P. 95-100.
2. YAMADA Hiroyuki; KAWASAKI M., TOKURA Y. Epitaxial growth and valence control of strained perovskite SrFeO<sup>3</sup> films// Applied physics letters 2002.- V. 80.- No. 4.- P. 622-624.